


文 章 内 容

标 题:	单晶硅表面键合复合份菁及其伏—安特性
作 者:	马国营 曹子祥
发表年限:	1996
发表期号:	6
单 位:	西北大学化学系
关键词:	光敏染料 单晶硅 表面 键合 伏安特性 半导体
摘 要:	<p>用化学方法将 3 种复合份菁化学键合于单晶硅表面, 并用激光拉曼光谱和 X—光电子能谱进行了表征。暗的和光照的伏安特性测量表明键合染料的 n—S i 表面具有光生伏特效应, 证实了 n—S i 一侧存在于电子势垒。</p> <p> 单晶硅表面键合复合份菁及其伏—安特性.pdf</p>

打 印

关 闭